

VCR2N, VCR4N, VCR7N

N-Channel Silicon Voltage Controlled Resistor JFET

- Small Signal Attenuators
- Filters
- Amplifier Gain Control
- Oscillator Amplitude Control

Absolute maximum ratings at $T_A = 25^\circ\text{C}$.

Reverse Gate Source & Reverse Gate Drain Voltage	- 15 V
Continuous Forward Gate Current	10 mA
Continuous Device Power Dissipation	300 mW
Power Derating	2.4 mW/°C

At 25°C free air temperature: Static Electrical Characteristics

		VCR2N		VCR4N		Process	
		NJ72		NJ16			
		Min	Max	Min	Max	Unit	Test Conditions
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS}$	- 15		- 15		V	$I_G = -1 \mu\text{A}, V_{DS} = 0\text{V}$
Gate Reverse Current	I_{GSS}		- 5		- 0.2	nA	$V_{GS} = -15\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	- 1	- 3.5	- 3.5	- 7	V	$I_D = -1 \mu\text{A}, V_{DS} = 10\text{V}$

Dynamic Electrical Characteristics

Drain Source ON Resistance	$r_{ds(on)}$	20	60	200	600	Ω	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 0\text{A}$	f = 1 kHz
Drain Gate Capacitance	C_{dg}		7.5		3	pF	$V_{DG} = 10\text{V}, I_S = 0\text{A}$	f = 1 MHz
Source Gate Capacitance	C_{sg}		7.5		3	pF	$V_{DG} = 10\text{V}, I_D = 0\text{A}$	f = 1 MHz

At 25°C free air temperature: Static Electrical Characteristics

		VCR7N		Process	
		NJ01			
		Min	Max	Unit	Test Conditions
Gate Source Breakdown Voltage	$V_{(BR)GSS}$	- 15		V	$I_G = -1 \mu\text{A}, V_{DS} = 0\text{V}$
Gate Reverse Current	I_{GSS}		- 0.1	nA	$V_{GS} = -15\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$
Gate Source Cutoff Voltage	$V_{GS(OFF)}$	- 2.5	- 5	V	$I_D = -1 \mu\text{A}, V_{DS} = 10\text{V}$

Dynamic Electrical Characteristics

Drain Source ON Resistance	$r_{ds(on)}$	4000	8000	Ω	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 0\text{A}$	f = 1 kHz
Drain Gate Capacitance	C_{dg}		1.5	pF	$V_{DG} = 10\text{V}, I_S = 0\text{A}$	f = 1 MHz
Source Gate Capacitance	C_{sg}		1.5	pF	$V_{DG} = 10\text{V}, I_D = 0\text{A}$	f = 1 MHz

VCR2N & VCR4N TO-18 Package

See Section G for Outline Dimensions

Pin Configuration

1 Source, 2 Drain, 3 Gate & Case

VCR7N TO-72 Package

See Section G for Outline Dimensions

Pin Configuration

1 Source, 2 Drain, 3 Gate, 4 Case





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.